

# 目 录

1.	产品概述	2
2.	主要特性	2
3.	系统框图	2
4.	封装及引脚说明	
5.	功能描述	
	5.1 输出模式和选项脚位	4
	5.2 按键最长输出时间	
	5.3 低功耗模式	4
	5.4 灵敏度调整	4
6.	应用电路	5
7.	电气特性	6
	7.1 电气特性极限参数	
	7.2 直流特性	6
8.	封装信息	7
	8.1 SOT23-6封装	7
	8.2 DFN2x2-6L封装尺寸	8
	8.3 DFN2x2-6L编带信息	9
a	历中记录	a





# 单触控单输出 IC

文件编号: PT-DS24011

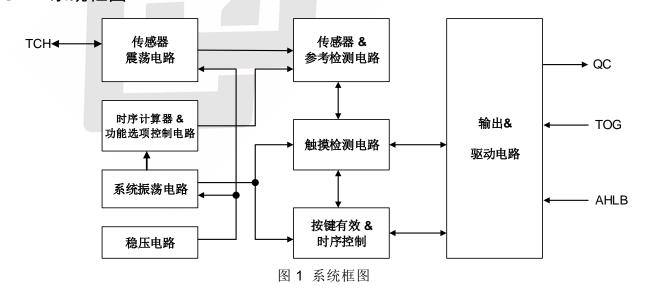
#### 1. 产品概述

PT2041D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。

#### 2. 主要特性

- 工作电压范围: 2.4~5.5V
- 抗干扰性能优良: 内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
- 待机工作电流:典型值 2uA@VDD=3V/无负载
- 按键最长响应时间: 低功耗模式下约 160ms@V<sub>DD</sub>=3V
- 可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
- 输出模式选择(TOG): 同步输出或锁存(toggle)输出
- CMOS 输出(QC)有效电平选择(AHLB): 高电平或低电平输出有效
- 按键最长输出时间: 16 秒(±30%)
- 上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
- 封装形式: SOT23-6、DFN2\*2-6L
- 不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用 若有抗干扰能力要求高的应用场景,请选用 PT2022T6。

#### 3. 系统框图





# 4. 封装及引脚说明

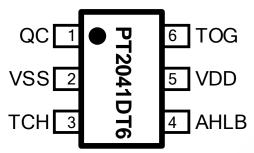


图 2 SOT23-6 管脚示意图

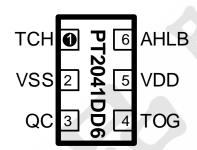


图 3 DFN2x2-6L 管脚示意图注: 引脚布局与 SOT23-6 反向

表 1 引脚说明表

管脚名称	I/O	描述
QC	0	输出脚, CMOS 输出
VSS	Р	地
TCH	I	触摸感应输入
AHLB	I-PL	输出高电平有效或低电平有效选择
ANLD		0 (默认值): 高电平有效; 1: 低电平有效
VDD	Р	电源
		输出模式选择
TOG	I-PL	0 (默认值): 同步输出;
		1: 锁存(toggle)输出

#### 引脚类型:

I: CMOS 输入 O: CMOS 输出

I/O: CMOS 输入/输出

P: 电源/接地

I-PH: CMOS 输入内置上拉电阻 I-PL: CMOS 输入内置下拉电阻

www.pintengtech.com 版本号 V1.4 3 / 9



#### 5. 功能描述

#### 5.1 输出模式和选项脚位

- AHLB 和 TOG 选项脚位为锁存类型:上电默认状态为 0,若上电前管脚被接至 VDD,则上电后状态变为 1,且不会有电流漏电。
- TOG 脚位:选择同步输出或锁存(toggle)输出。
- AHLB 脚位:选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。

QC 脚(CMOS 输出)选项特性:

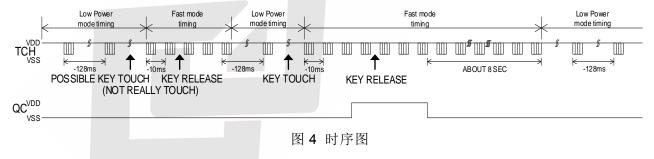
TOG	AHLB	端口 QC 选项特性						
0	0	同步模式、CMOS 高电平有效						
0	1	同步模式、CMOS 低电平有效						
1	0	锁存(toggle)输出,上电状态=0						
1	1	锁存(toggle)输出,上电状态=1						

#### 5.2 按键最长输出时间

● 若有物体覆盖触摸盘或环境突然变化,可能导致触摸检测持续有效。IC内部触控算法检测到输出有效持续时间达到设定值 16S(±30%)时,系统会回到上电初始状态,且输出变为无效。

#### 5.3 低功耗模式

- 上电 1S 进入低功耗模式(便于生产测试)
- 按键唤醒后 8S 无触摸进入低功耗模式



#### 5.4 灵敏度调整

IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度,灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用,下面是一些调整灵敏度的方法:

1) 调整触摸盘大小:

在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但触摸盘尺寸必须在有效范围内。

2) 调整介质面板厚度:

在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。

3) 调整 Cs 电容值

在其它条件不变的情况下,触摸盘上未接对地 Cs 电容时,灵敏度最高,反之 Cs 电容越大灵敏度变低,Cs 电容可用范围:  $(1 \le Cs \le 50pF)$ 。



#### 6. 应用电路

Cm为PT2022T6所需预留电容, 抗干扰能力无法满足时, 可用PT2022T6直接替换

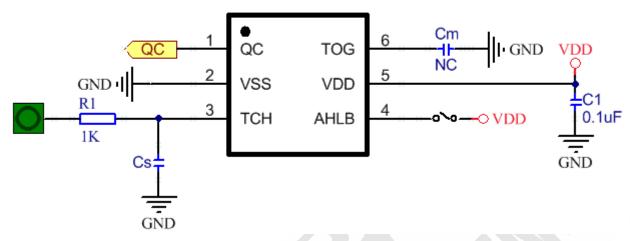


图 5 电路示意图

#### 注:

- 1) 在 PCB 上从触摸盘到 TCH 脚的走线越短越好,且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
- 2) 电源供电必须稳定, 若电源电压发生快速漂移或跳变, 可能造成灵敏度异常或误检测。
- 3) 覆盖在 PCB 上的介质,不得含有金属或导电组件成份,表面涂料亦同样要求。
- 4) 必须在 VDD 和 GND 间使用 C1 电容(104 或更大容量); 且应采取与 IC 的 VDD 和 GND 管脚 最短距离布线。
- 5) 可利用 Cs 电容调整灵敏度, Cs 电容值越小灵敏度越高, 灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整, Cs 电容值的范围为 1~50pF。
- 6) 调整灵敏度的电容(Cs)必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器,如 X7R、NPO。针对触摸应用,建议选择 NPO 电容器,以降低因温度变化而影响灵敏度。

www.pintengtech.com 版本号 V1.4 5 / 9



# 7. 电气特性

### 7.1 电气特性极限参数

表 2 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	$V_{DD}$	-	-0 to +5.5	V
输入电压	Vı	所有 I/O口	所有 I/O口 -0.3 to V <sub>DD</sub> +0.3	
工作温度	TA	-	-20~ +70	$^{\circ}\! \mathbb{C}$
储藏温度	T <sub>STG</sub>	-	-40~ +125	$^{\circ}$ C

### 7.2 直流特性

表 3 如无特殊说明 VDD=2.4V~5.5V, Temp=25°C

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V <sub>DD</sub>		2.4	3	5.5	V
输入高电压	Vih	V <sub>DD</sub> =5V,AHLB	0.7*VDD			V
· 相八同电压	VIH	V <sub>DD</sub> =5V,TOG	0.7 VDD			V
<b>■</b> 輸入低电压	Vıl	V <sub>DD</sub> =5V,AHLB			0.3*VDD	V
相八队电压	VIL	V <sub>DD</sub> =5V,TOG			0.5 VDD	V
输出拉电流	输出拉电流 I <sub>OH</sub> V <sub>DD</sub> =3V, V			6		mA
输出灌电流	loL	V <sub>DD</sub> =3V, VOL=0.3V		7		mA
下拉电阻	R <sub>PL</sub>	V <sub>DD</sub> =3V (TOG、AHLB)	24	30	36	Kohm
输出响应时间	T <sub>R</sub>	V <sub>DD</sub> =3V、快速模式			40	ms
湘田州处时间		V <sub>DD</sub> =3V、低功耗模式			160	1115
工作电流		V <sub>DD</sub> =3V,低功耗模式(无负载)		2	2.5	uA
그가면에	I <sub>SB</sub>	V <sub>DD</sub> =3V,快速模式(无负载)		20	25	uA



#### 封装信息 8.

#### 8.1 SOT23-6封装

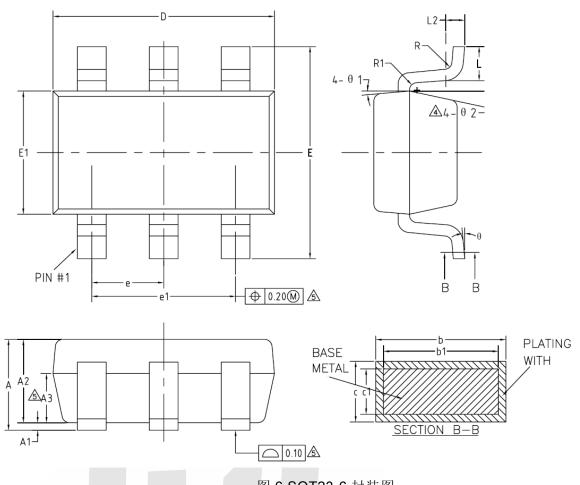


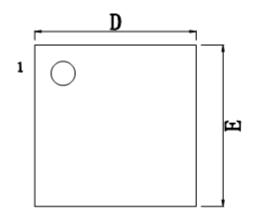
图 6 SOT23-6 封装图

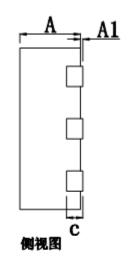
表 4 SOT23-6 封装尺寸

						Unit:	mm
Symbol	Min	Тур	Max	Symbol	Min	Тур	Max
Α	-	-	1.25	е	0.90	0.95	1.00
A1	0	-	0.15	e1	1.80	1.90	2.00
A2	1.00	1.10	1.20	L	0.35	0.45	0.60
А3	0.60	0.65	0.70	L1		0.59RET	
В	0.36	-	0.50	L2	0.25BSC		
b1	0.36	0.38	0.45	R	0.10	-	-
С	0.14	-	0.20	R1	0.10	-	0.20
c1	0.14	0.15	0.16	θ	0	-	8°
D	2.826	2.926	3.026	θ1	3°	5°	7°
Е	2.60	2.80	3.00	θ2	6°	-	14°
E1	1.526	1.626	1.726				



# 8.2 DFN2x2-6L封装尺寸







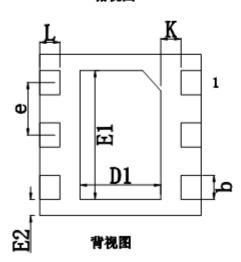


图 7 DFN2x2-6L 封装图

表 5 DFN2x2-6L 封装尺寸

Symbol	Min	Тур	Max		
Α	0.50	0.55	0.60		
A1	0.00	_	0.05		
b	0.25	0.3	0.35		
С	0.203TYP				
D	1.95	2.00	2.05		
D1	0.9	1.00	1.10		
Е	1.95	2.00	2.05		

		Unit:	mm			
Symbol	Min	Тур	Max			
E1	1.55	1.60	1.65			
E2	0.20REF					
е	0.65BSC					
K	0.25REF					
L	0.20	0.25	0.30			



# 8.3 DFN2x2-6L编带信息

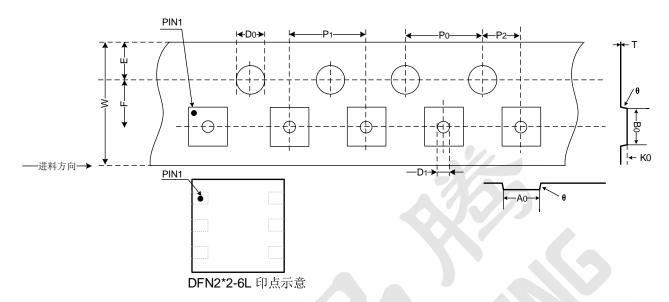


图 8 DFN2x2-6L 编带示意

表 6 DFN2x2-6L 编带尺寸

						Unit:	mm
Symbol	Min	Тур	Max	Symbol	Min	Тур	Max
W	7.9	8.00	8.10	D1	·	1.00	1.10
A0	2.15	2.25	2.35	D0	-	1.50	1.60
B0	2.15	2.25	2.35	P0	3.90	4.00	4.10
K0	0.85	0.95	1.05	P1	3.90	4.00	4.10
E	1.65	1.75	1.85	P2	1.90	2.00	2.10
F	3.40	3.50	3.60	Т	0.20	0.22	0.24
				θ		10°	

# 9. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2024-11-05
V1.1	添加上电 <b>1S</b> 进入低功耗描述	2024-02-25
V1.2	添加DFN2x2-6L编带信息	2025-08-20
V1.3	添加DFN2x2-6L封装信息	2025-09-16
V1.4	更新应用电路图R1电阻参数	2025-09-24

最新版本以官网为准,请及时下载查阅!